

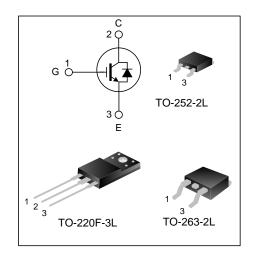
5A、600V绝缘栅双极型晶体管

描述

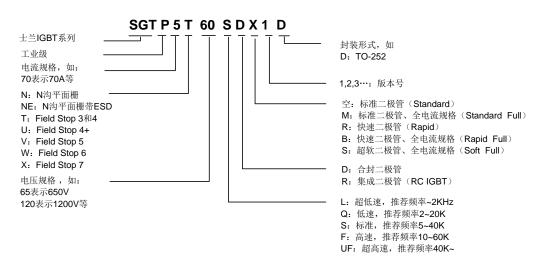
SGTP5T60SD1D/F/S 绝缘栅双极型晶体管采用士兰微电子第三代场截止(Field Stop)工艺制作,具有较低的导通损耗和开关损耗,该产品可应用于 UPS,SMPS 以及 PFC 等领域。

特点

- ◆ 5A, 600V, V_{CE(sat)(典型值)}=1.5V@I_C=5A
- ◆ 低导通损耗
- 快开关速度
- ◆ 高输入阻抗



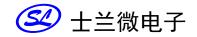
命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SGTP5T60SD1DTR	TO-252-2L	P5T60SD1	无卤	编带
SGTP5T60SD1F	TO-220F-3L	P5T60SD1	无铅	料管
SGTP5T60SD1S	TO-263-2L	P5T60SD1S	无卤	料管
SGTP5T60SD1STR	TO-263-2L	P5T60SD1S	无卤	编带

杭州士兰微电子股份有限公司



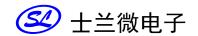
极限参数(除非特殊说明, T_c =25°C)

参数		<i>ħħ</i> ; 🗆	参数范围			兴 / ÷
		符号	SGTP5T60SD1D	SGTP5T60SD1F	SGTP5T60SD1S	单位
集电极-射极电压		V _{CE}		600		
栅极-射极电压	栅极-射极电压		±30			V
集电极电流	F c + 47 c + 25°C			10		A
亲电恢电 <u>机</u>	T _C =100°C	I _C		5		A
集电极脉冲电流		I _{CM}	15			Α
二极管电流		l _F	10		Α	
短路维持时间		Tsc	10			110
$(V_{GE}=15V, V_{CC}=300V)$		150		10		μs
耗散功率(T _C =25℃)		P_D	82 35 83		83	W
工作结温范围		T_J	-55∼+150			°C
贮存温度范围		T _{stg}	-55∼+150		°C	

热阻特性

参数	符号	参数范围			单位
多 数	1寸 写	SGTP5T60SD1D	SGTP5T60SD1F	SGTP5T60SD1S	半世
芯片对管壳热阻(IGBT)	$R_{ heta JC}$	1.51	3.6	1.5	°C/W
芯片对管壳热阻(FRD)	$R_{ heta JC}$	2.14	3.7	2.6	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	72	63	51	°C/W

杭州士兰微电子股份有限公司 http://www.silan.com.cn



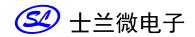
IGBT 电性参数(除非特殊说明,T_c=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集射击穿电压	BV _{CE}	V _{GE} =0V, I _C =250μA	600			V
集射漏电流	I _{CES}	V _{CE} =600V, V _{GE} =0V			200	μA
栅射漏电流	I _{GES}	V _{GE} =20V, V _{CE} =0V			±400	nA
栅极开启电压	$V_{GE(th)}$	I _C =250μΑ,V _{CE} =V _{GE}	3.5	5.5	6.5	V
饱和压降	V	I _C =5A, V _{GE} =15V		1.5	2.0	V
12171111111111111111111111111111111111	$V_{CE(sat)}$	I _C =5A, V _{GE} =15V, T _C =125°C		1.7		V
输入电容	C _{ies}			340		
输出电容	Coes	V _{CE} =30V, V _{GE} =0V, f=1MHz		26		pF
反向传输电容	C _{res}			7.6		
开启延迟时间	T _{d(on)}			7		
开启上升时间	Tr	V _{CE} =400V		14		
关断延迟时间	T _{d(off)}	I _C =5A		18		ns
关断下降时间	T _f	$R_g=10\Omega$		145		
导通损耗	E _{on}	V _{GE} =15V		0.2		
关断损耗	E _{off}	感性负载		0.07		mJ
开关损耗	E _{st}			0.27		
栅电荷	Q_g			18.5		
发射极栅电荷	Q_ge	V _{CE} =400V, I _C =5A, V _{GE} =15V		5.1		nC
集电极栅电荷	Q_{gc}			8.6		

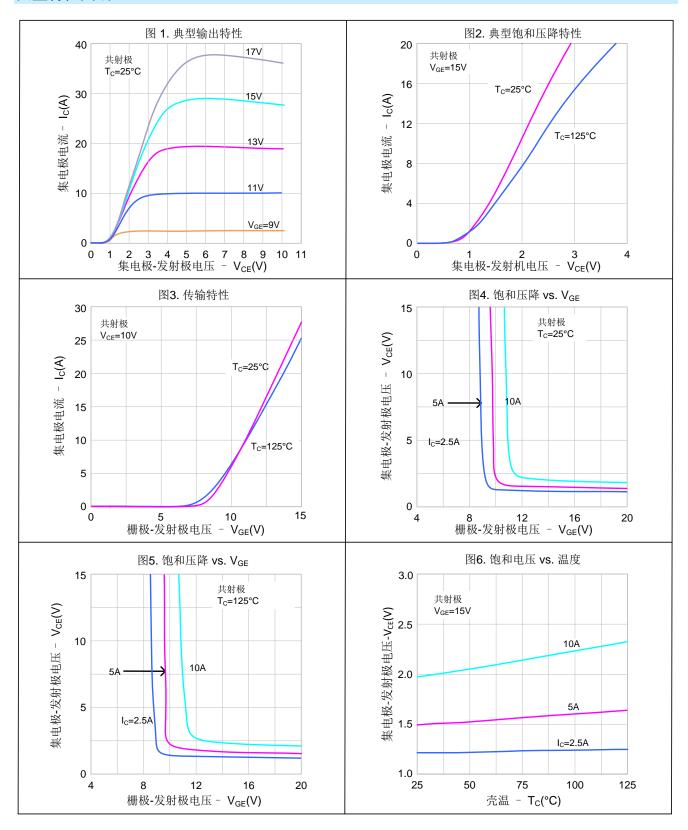
FRD 电性参数(除非特殊说明,T_c=25°C)

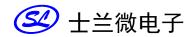
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
一扭等工点压败		I _F =5A,T _C =25°C		1.3	1.8	V
二极管正向压降		I _F =5A,T _C =125°C		1.1		V
二极管反向恢复时间	Trr	I _{ES} =5A, dI _{ES} /dt=200A/μs		40		ns
二极管反向恢复电荷	Q _{rr}	I _{ES} =5A, dI _{ES} /dt=200A/μs		80		nC

杭州士兰微电子股份有限公司 http://www.silan.com.cn

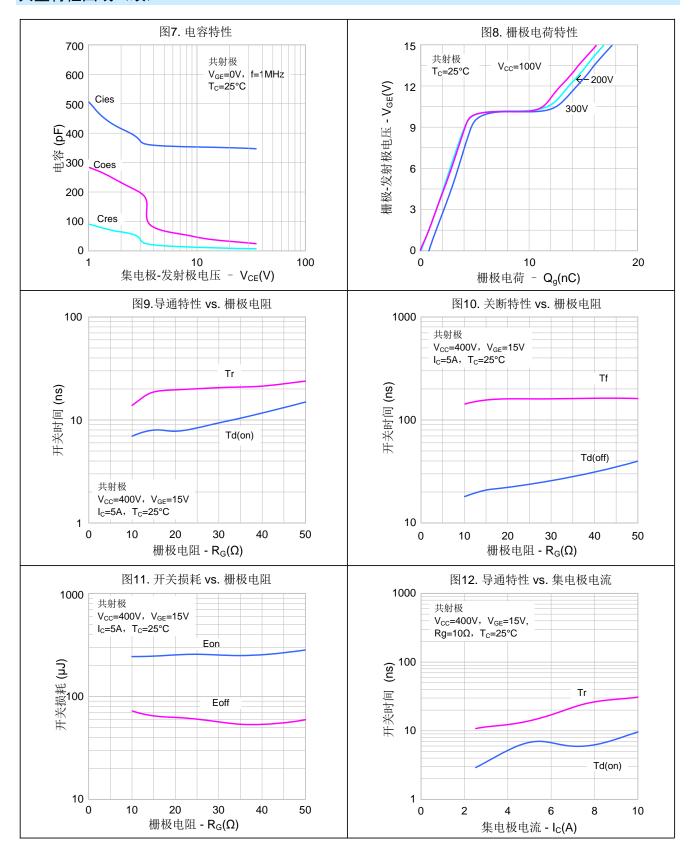


典型特性曲线

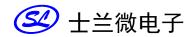




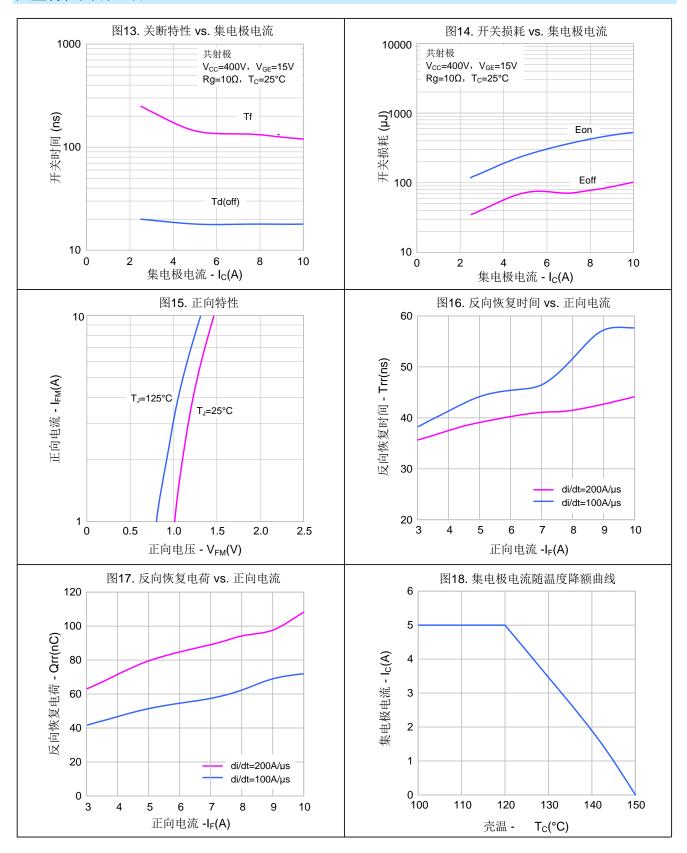
典型特性曲线(续)



版本号: 1.6 共10页 第5页

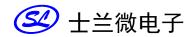


典型特性曲线 (续)

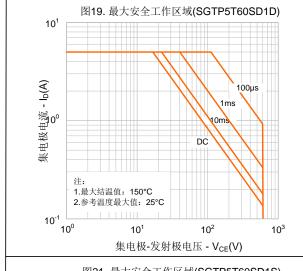


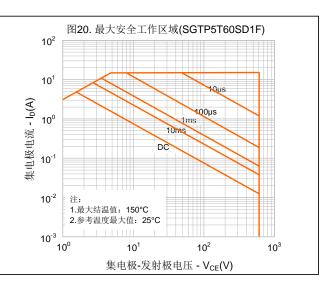
版本号: 1.6

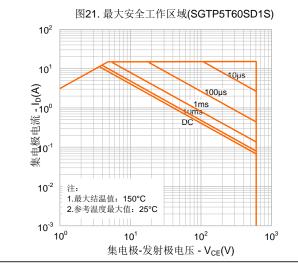


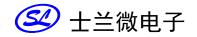


典型特性曲线 (续)



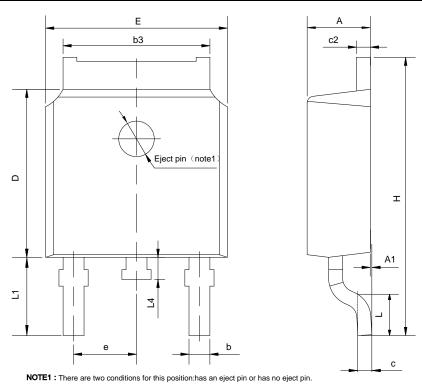






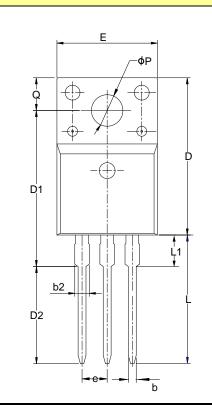
封装外形图

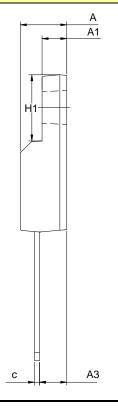




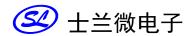
SYMBOL	N	/ILLIMET	ΓER
STIVIBUL	MIN	NOM	MAX
А	2.10	2.30	2.50
A1	0	_	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
С	0.45	_	0.65
c2	0.45		0.65
D	5.80	6.10	6.40
Е	6.30	6.60	6.90
е		2.30TYP	
Н	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

TO-220F-3L 单位: 毫米

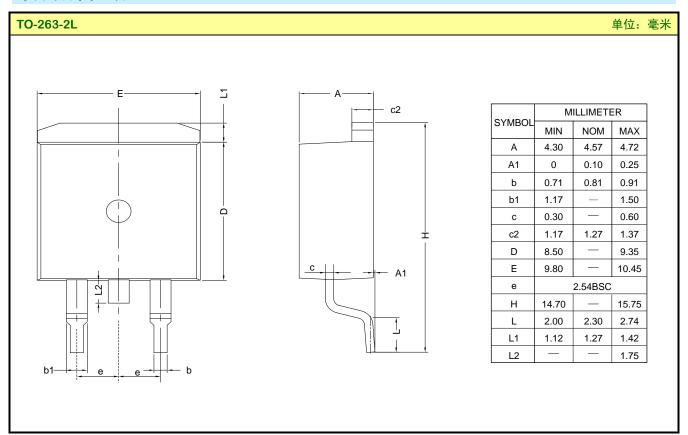




	М	ILLIMETI	ER
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
А	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	_	-	1.47
С	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
е		2.54BS0	
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	-	_	3.50
ФΡ	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55



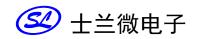
封装外形图 (续)



重要注意事项:

- 1. 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知。
- 2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料,并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书,包括其中的电路操作注意事项。
- 3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
- 4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值,否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并 采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- 5. 购买产品时请认清我司商标,如有疑问请与本公司联系。
- 6. 产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
- 7. 我司网站 http://www.silan.com.cn

版本号: 1.6



SGTP5T60SD1D/F/S 说明书

产品名称:	SGTP5T60SD1D/F/S	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn
版 本:	1.6		
修改记录:			
	牧图 10 I _C =5A		
版 本:	1.5		
修改记录:			
2. 添加	n短路保护时间		
3. 更新	所说明书模板		
版 本:	1.4		
修改记录:			
1. 增力	川环境热阻		
版 本:	1.3		
修改记录:			
1. 更新	新命名规则		
版 本:	1.2		
修改记录:			
1. 添加	旧TO-263-2L和TO-220F-3L		
2. 添加	口降额曲线		
版 本:	1.1		
修改记录:			
1. 修改	牧 V _{GE} 的大小		
版 本:	1.0		
修改记录:			
1. 正元	式版本发布		

杭州士兰微电子股份有限公司

版本号: 1.6